## 1 Polaritón plasmónico de grafeno acústico I

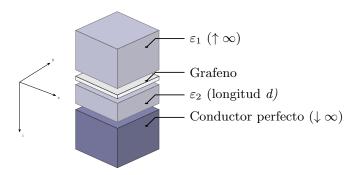


Figure 1: Esquema del sistema AGP-I.

**Descripción.** Polaritón plasmónico de grafeno acústico I: Una monocapa de grafeno a una distancia d de un sustrato metálico infinito que asumirás que es un conductor perfecto. El espacio entre la monocapa y el metal está relleno con un material de constante dieléctrica  $\epsilon_2$ . La monocapa está en contacto con un dieléctrico  $\epsilon_1$ . Comparar con los resultados del punto anterior. Estudiar el caso límite  $d \to \infty$ .

## Ecuación característica.

$$\epsilon_2 \omega^2 \cosh(dk_x) + (\epsilon_1 \omega^2 - 2ck_x \omega_D) \sinh(dk_x) = 0.$$
 (1)

Dividiendo por  $\cosh(dk_x)$  queda la forma con tanh:

$$\epsilon_2 \omega^2 + (\epsilon_1 \omega^2 - 2ck_x \omega_D) \tanh(dk_x) = 0, \qquad \Longrightarrow \qquad \tanh(dk_x) = \frac{\epsilon_2 \omega^2}{2ck_x \omega_D - \epsilon_1 \omega^2}.$$

## Relación de dispersión.

$$\omega^2(k_x)_{AGP-1} = \frac{2 c k_x \omega_D \sinh(dk_x)}{\epsilon_1 \sinh(dk_x) + \epsilon_2 \cosh(dk_x)}.$$
 (3)

**Asíntotas.** Límite  $k_x \to 0$ . Con  $x = dk_x$ , usando  $\sinh x \approx x$  y  $\cosh x \approx 1$ :

$$\omega^2(k_x)_{AGP-1} \approx \frac{2ck_x\omega_D x}{\epsilon_1 x + \epsilon_2} = \frac{2cd\omega_D}{\epsilon_2} k_x^2 \implies \left[ \omega(k_x) \sim \sqrt{\frac{2cd\omega_D}{\epsilon_2}} k_x \right].$$

**Limite**  $k_x \to \infty$ . Con  $\sinh x \sim \cosh x \sim \frac{1}{2}e^x$ :

$$\omega^2(k_x) \to \frac{2 c k_x \omega_D}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \implies \left[ \omega(k_x) \sim \sqrt{\frac{2c\omega_D}{\epsilon_1 + \epsilon_2}} \sqrt{k_x} \right]$$

## Agrupaciones.

- Asíntota baja (AGP acústico):  $\omega \propto k_x$  para  $k_x \to 0$ .
- Asíntota alta común:  $\omega^2 \to \frac{2ck_x\omega_D}{\epsilon_1+\epsilon_2}$ .

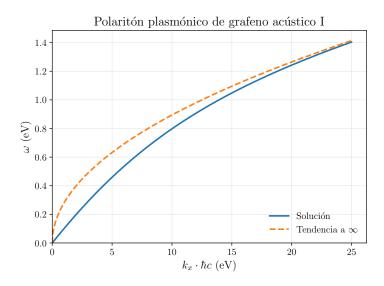


Figure 2: Relación de dispersión  $\omega(k_x)$  del AGP-I (Ec. (3)) y sus asíntotas.